Radical-Enhanced ALD 法による Ge 基板上 Al ジャーマネイトの 形成機構に関する検討

Study on the formation of Al germanate on Ge substrate by radical-enhanced ALD 諏訪東京理科大学¹,山梨大学²,弘前大学³

橫平知也¹, °梁池昂生¹, 柳炳學², 山本千綾², 山中淳二², 佐藤哲也², 岡本浩³, 福田幸夫¹

Tokyo Univ. of Science, Suwa,¹ Univ. of Yamanashi,² Hirosaki Univ.³

T. Yokohira, ¹ °K. Yanachi, ¹ B. Yoo, ² C. Yamamoto, ² J. Yamanaka, ² T. Sato, ²

H. Okamoto, ³ and Y. Fukuda¹

E-mail: y-fukuda@rs.suwa.tus.ac.jp

1. はじめに III 族金属のジャーマネイトは Ge 基板と電子 的に良好な界面を形成することが理論的に予想されており ⁽¹⁾、high-κ/Ge の中間層として期待されている。一方、我々 はTMAとマイクロ波リモートプラズマ生成酸素ラジカルの交 互供給により Ge 基板上に Al₂0₃を形成する過程において Al ジャーマネイトが自発的に形成されることを報告してきた ⁽²⁾。Al ジャーマネイトが形成されるためには、成長表面にお いて吸着 Al 原子と下地 Ge 原子との置換反応が必要となる。 本研究では、上記ジャーマネイト形成機構を理解する目的で、 表面反応に関わる酸素ラジカルやイオンの役割を検討した ので報告する。

2. 実験方法 まず、AI ジャーマネイトの形成に関わるイオ ンの役割を明らかにするために、リモートプラズマ源と成膜 室の間に接地金属メッシュを配置し、この有無による基板表 面上でのプラズマの状態を Langmuir プローブ法により測定 した。次に、金属メッシュの有り無しの条件下で TMA と酸素 ラジカルの交互供給により p-Ge (100) 基板上に AI₂O₃ を形成 し、得られた膜に対して XPS、HR-TEM、HAADF 分析を行った。 成膜条件は Ar/O₂=200/20 sccm、圧力 1.4 Torr、マイクロ波 パワー100 W、基板温度 300 ℃である。

3. 実験結果 Fig.1 に金属メッシュの有無によるプローブ 電流の変化を示す。メッシュの挿入により、イオン電流密度 が数十分の1に低減されていることが分かる。解析の結果シ ース電位は5.4Vであった。Fig.2は、それぞれ(a)メッシュ 有り及び(b)メッシュ無しの条件で形成した試料の断面 TEM 像である。メッシュ有りの試料では界面層が観察されないが、 メッシュ無しの試料では数ナノメータ厚の界面層が Al₂0₃ と Ge の間に形成されていることが分かる。Fig.3 は Fig.2(b) の HAADF 像である。界面層に相当する部分は組成傾斜の Al ジャーマネイト⁽²⁾であると推定される。

4. まとめ 以上、REALD 法による Ge 基板上への Al ジャーマ ネイト形成について検討した。比較実験結果より、ジャーマ ネイトの形成機構には、数 eV 程度の低エネルギーイオン照 射により誘起される Al と Ge 原子の置換反応が関与している と思われる。

謝辞 本研究は一部科研費の助成のもとに行われた。

文献 (1) M. Houssa *et al.*, APL 92, 242101(2008). (2) Y. Fukuda *et al.*, APL 102, 132904(2013).



Fig.1. $I_{\rm p}$ versus $V_{\rm p}\,$ measured with and without metal mesh.



Fig.2. X-TEM images of the samples grown (a) with mesh and (b) without mesh.

Еролу	Inte	rlayer	
Al ₂ O ₃			
Ge			

Fig.3. HAADF image of the sample grown without mesh.